ЖЭТФ, 1998, том 114, вып. 5(11), стр. 1795–1803

ОПТИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ И ЦИКЛОТРОННЫЙ РЕЗОНАНС НА УРОВНЯХ ЛАНДАУ, РАСЩЕПЛЕННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ

В. Я. Демиховский*, А. А. Перов[†]

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 603600, Нижний Новгород, Россия

Поступила в редакцию 23 марта 1998 г.

Исследована структура электронного спектра и найдены правила отбора для переходов между магнитными подзонами в поверхностной 2D-сверхрешетке квантовых точек, помещенной в перпендикулярное магнитное поле. Рассчитаны вероятности и определена форма линий поглощения для разрешенных и запрещенных прямых дипольных переходов между подзонами, отщепившимися от различных уровней Ландау.

1. ВВЕДЕНИЕ

Исследование квантовых состояний блоховского электрона в магнитном поле в течение нескольких десятилетий привлекает внимание теоретиков [1-5] и экспериментаторов [6-8]. Однако до настоящего времени экспериментально не наблюдались эффекты, подтверждающие существование расщепленной структуры уровней Ландау. Это связано с тем, что для наблюдения подобных эффектов в реальных кристаллах необходимы недостижимые пока магнитные поля порядка 1000 Тл. В то же время магнитные подзоны блоховских электронов могли бы наблюдаться в искусственных кристаллах — поверхностных 2D-сверхрешетках, помещенных в перпендикулярное магнитное поле. В последнее десятилетие достигнут прогресс в создании таких полупроводниковых структур [9] с длиной свободного пробега, существенно превышающей период потенциала. Недавно были предприняты первые попытки наблюдения спектров типа «бабочек» Ховштадтера [4] в 2D-сверхрешетках по результатам измерения магнитосопротивления [10]. Другая возможность экспериментального наблюдения структуры спектра состоит в исследовании магнитооптики таких структур. Настоящая работа посвящена аналитическому и численному исследованию поглощения электромагнитного излучения в решетках квантовых точек, находящихся в магнитном поле.

2. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОД РАСЧЕТА

В рамках предлагаемой модели гамильтониан электрона в периодическом 2D-потенциале, в постоянном магнитном поле и в поле электромагнитной волны имеет вид

*E-mail: demi@phys.unn.runnet.ru

[†]E-mail: perov@phys.unn.runnet.ru

9*

 $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_{int}$. В качестве невозмущенного гамильтониана выбран гамильтониан электрона в перпендикулярном магнитном поле и в поле периодического потенциала

$$\hat{H}_{0} = \frac{1}{2m^{*}} \left(\hat{\mathbf{p}} + \frac{|e|\mathbf{A}_{0}}{c} \right)^{2} + V(x, y),$$
(1)

где функция $V(x, y) = V_0 \cos^2(\pi x/a) \cos^2(\pi y/a)$ моделирует периодический потенциал квадратной решетки квантовых точек, $A_0 = H(0, x, 0)$ — векторный потенциал постоянного магнитного поля, m^* — эффективная масса электрона. Собственная функция гамильтониана (1), удовлетворяющая обобщенным условиям Блоха в магнитном поле

$$\psi_{\mathbf{k}}(x,y) = \psi_{\mathbf{k}}(x+qa,y+a)\exp(-ik_{x}qa)\exp(-ik_{y}a)\exp(-2\pi ipy/a), \tag{2}$$

представляется в виде ряда по осцилляторным функциям $\varphi_N(x)$ вдоль направления x и плоским волнам в направлении y [11–13]:

$$\psi_{\mathbf{k}}^{N_{0},n_{0}}(x,y) = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_{n=1}^{p} C_{Nn}^{N_{0},n_{0}}(\mathbf{k}) \sum_{j=-\infty}^{+\infty} \varphi_{N} \left(\frac{x - x_{0} - jqa - nqa/p}{l_{H}} \right) \times \exp\left(ik_{x} \left[jqa + \frac{nqa}{p}\right]\right) \exp\left(2\pi iy\frac{jp + n}{a}\right) \exp(ik_{y}y).$$
(3)

Квантовые числа N_0 , n_0 определяют магнитную подзону: $n_0 = 1, p$ — номер подзоны, отщепившейся от N_0 -го уровня Ландау. Параметр $p/q = |e|Ha^2/2\pi\hbar c$ (p и q — целые числа) равен числу квантов магнитного потока через элементарную ячейку решетки площадью a^2 , $l_H = \sqrt{c\hbar/|e|H}$ — магнитная длина. Численный метод расчета этих функций предложен авторами в работах [11–13]. Для отыскания спектра и волновых функций гамильтониан \hat{H}_0 записывался в представлении симметризованных функций, стоящих при коэффициентах $C_{N_0,n_0}^{N_0,n_0}(\mathbf{k})$ в выражении (3). Собственные значения $E_{N_0,n_0}(\mathbf{k})$ и собственные функции $C_{N_n}^{N_0,n_0}(\mathbf{k})$ гамильтониана (1) в этом представлении находились путем диагонализации его матрицы.

Воздействие на систему электромагнитной волны, распространяющейся вдоль вектора **H** и линейно поляризованной вдоль оси x, учитывается по теории возмущений. Гамильтониан возмущения есть

$$\hat{H}_{int} = -i \frac{|e|\hbar}{m^* c} A_1 \exp(-i\omega t) \frac{\partial}{\partial x}.$$
(4)

В выражении (4) величина A₁ — векторный потенциал поля электромагнитной волны.

Число фотонов, поглощенных в единицу времени единицей площади поверхности, равно

$$\alpha = \frac{2\pi}{\hbar\Phi} \int |P_{\mathbf{k}\mathbf{k}}^{i\to f}|^2 \delta \left[E_f(\mathbf{k}) - E_i(\mathbf{k}) - \hbar\omega \right] \frac{2}{(2\pi)^2} d^2k, \tag{5}$$

где Φ — плотность потока фотонов. Здесь предполагается, что волновые векторы электрона в начальном и конечном состояниях совпадают, т.е. речь идет о прямых межзонных переходах. Интегрирование в (5) проводится по всем заполненным начальным состояниям. Из (3) и (4) следует, что матричный элемент прямого дипольного перехода имеет вид

$$P_{\mathbf{k}\mathbf{k}}^{i \to f} = A_1 \frac{|e|}{qam^*c} \sum_{N,M=0}^{\infty} \sum_{n,s=1}^{p} C_{Ms}^{f*}(\mathbf{k}) C_{Nn}^i(\mathbf{k}) \times \\ \times \sum_j \int_{-qa/2}^{qa/2} \varphi_M \left[\frac{x - x_0 - jqa - nqa/p}{l_H} \right] \hat{p}_x \varphi_N \left[\frac{x - x_0 - jqa - nqa/p}{l_H} \right] dx.$$
(6)

В сильных магнитных полях, когда выполнены неравенства $qa \gg \sqrt{N} l_H$, $\sqrt{M} l_H$; $V_0 \ll \hbar\omega_c$, осцилляторные функции для всех эффективных N и M в (6) сильно локализованы на магнитной элементарной ячейке. Поэтому вклад слагаемых с большими j в интеграл (6) будет экспоненциально малым. Ограничиваясь слагаемым с j = 0 и расширяя пределы интегрирования по x до бесконечности, получим

$$P_{\mathbf{kk}}^{i \to f} = -i \frac{|e|\hbar A_1}{qam^* cl_H \sqrt{2}} \sum_{N=0}^{\infty} \sum_{n,s=1}^{p} \left[C_{N-1,s}^{f*}(\mathbf{k}) C_{Nn}^i(\mathbf{k}) \sqrt{N} - C_{N+1,s}^{f*}(\mathbf{k}) C_{Nn}^i(\mathbf{k}) \sqrt{N+1} \right].$$
(7)

Здесь i и f задаются набором двух квантовых чисел, определяющих номер магнитной подзоны Ландау.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Обсудим, прежде всего, рассчитанную структуру электронного спектра. Все параметры периодического потенциала и величины магнитных полей приведены в подписях к рисункам. На рис. 1*а* показаны уровни энергии при $\mathbf{k} = 0$, соответствующие краям магнитных подзон. По вертикальной оси отложено число квантов магнитного потока через элементарную ячейку при $p/q \ge 2$. Видно, что в этой области магнитных полей уровни имеют тенденцию сгущаться к невозмущенным уровням Ландау. В области p/q < 2 (не показанной на рисунке) магнитные подзоны Ландау не образуются и возникают спектры типа «бабочки» Ховштадтера [4]. Можно заметить, что общая ширина расщепившихся уровней Ландау убывает с ростом номера N. На рис. 16 в увеличенном масштабе показан спектр магнитных подзон, отщепившихся от нулевого (N = 0) уровня Ландау, причем число квантов магнитного потока здесь изменяется на единицу: p/q = 15/1; 61/4; 31/2; 63/4; 16/1. Волновой вектор электрона в каждой подзоне лежит в пределах первой магнитной зоны Бриллюэна: $-\pi/qa \le k_x \le \pi/qa; -\pi/a < k_y < \pi/a.$ Можно видеть, что при p/q = 15/1 и 16/1 образовалось p не перекрывающихся магнитных подзон. Такие же подзоны образуются под каждым уровнем Ландау. В интервале между целочисленными значениями p/q число подзон резко меняется в зависимости от величины магнитного поля. Каждая подзона, существовавшая при целочисленном значении p/q, расщепляется на ряд подзон, так что их общее число под каждым уровнем Ландау равно p. На рис. 16 узкие подзоны при p/q = 61/4; 31/2; 63/4 неразличимы.

Рисунок 2 иллюстрирует распределение ширин подзон Ландау при p/q = 15/1. Видно, что ширина подзон, расположенных под одним уровнем Ландау, может различаться на несколько порядков. Наибольшую ширину имеют подзоны, расположенные вблизи



Рис. 1. Энергетический спектр решетки квантовых точек (Al,Ga)As (a = 80 нм; $V_0 = -20$ мэВ) в магнитном поле при $\mathbf{k} = 0$. Положение уровней Ландау показано жирными точками — a; структура магнитных подзон Ландау (0, n) при p/q = 15/1; 61/4; 31/2; 63/4; 16/1 — δ



Рис. 2. Ширина подзон Ландау (N, n) для N = 0, 1, 2 (n = 1, p) при p/q = 15/1, a = 80 нм; $V_0 = -20$ мэВ



Рис. 3. Распределение в пространстве действительной, мнимой частей ψ -функции, а также электронной плотности $|\psi|^2$ при **k** = 0 в состояниях: a - (1, 1); $\delta - (1, 2)$; s - (1, 11). Магнитное поле соответствует числу квантов магнитного потока p/q = 15/1. Параметры сверхрешетки: a = 80 нм; $V_0 = -20$ мэВ. Волновые функции состояний (1, 1) и (1, 11) преобразуются по представлению B, а (1, 2) — по представлению A группы C_2 . Распределение электронной плотности имеет симметрию группы C_{4V}

центра расщепленного уровня Ландау (см. также рис. 16). По-видимому, края этих подзон могут быть разрешены экспериментально в спектрах поглощения. Ширины подзон, расположенных по краям области расщепленного уровня Ландау, экспоненциально малы; они будут наблюдаться как дискретные уровни.

Рисунок 3 дает представление о распределении в пространстве реальных и мнимых частей электронных волновых функций, а также электронной плотности для состояний $(N_0, n_0) = (1, 1); (1, 2)$ и (1, 11) при **k** = 0. Расчеты проведены в магнитном поле, соответствующем p/q = 15/1. Темным цветом показаны области наибольших значений функции. Отложены только положительные значения действительных и мнимых частей ψ -функций.

Определенная нами зонная структура и волновые функции позволяют сделать заключение о характере оптического поглощения в рассматриваемой системе. Теоретико-групповой анализ устанавливает правила отбора для переходов в произвольной точке магнитной зоны Бриллюэна. В частности, при $\mathbf{k} = 0$ в дипольном приближении разрешенными оказываются переходы между состояниями, преобразующимися по различным неприводимым представлениям группы симметрии гамильтониана C_2 : симметричному A и антисимметричному B. Если начальное состояние i преобразуется по представлению A(B), то переход разрешен во все конечные состояния f = i + [2j + 1](j - целое число), которые преобразуются по представлению B(A). Численные расчеты матричных элементов подтверждают это правило. В точках зоны Бриллюэна с более низкой симметрией разрешены все переходы.

Вероятность перехода из различных подзон, отщепившихся от одного и того же уровня Ландау, может существенно различаться по величине. Так, она будет велика для переходов из состояний в центре подзон ($\mathbf{k} = 0$), отщепившихся от уровня Ландау с четным (нечетным) N и преобразующихся по представлению A(B). Если же начальное состояние при $\mathbf{k} = 0$ принадлежит подзоне, отщепившейся от четного (нечетного) уровня Ландау, и преобразуется по представлению B(A), то вероятность переходов становится относительно малой величиной. Это связано с тем, что волновая функция в подзоне (N_0 , n_0) строится в основном из осцилляторных функций N_0 -го уровня. Можно показать, что примесь соседних невозмущенных состояний Ландау $N_0 \pm 1$ в волновых функциях подзон N_0 -го расщепившегося уровня пропорциональна малому параметру

$$\beta = \frac{V_0}{\hbar\omega_c} \frac{2\pi l_H}{a}$$

который определяется отношением матричных элементов недиагонального блока матрицы гамильтониана \hat{H}_0 к элементам диагонального блока. (Структура матрицы гамильтониана подробно описана в работах [11, 12].) Если параметр $\beta \approx 1$, то примесь сосседних состояний Ландау окажется существенной и вероятности переходов из любого начального состояния будут одного порядка. Тот же параметр β определяет малость переходов между состояниями внутри одного расщепленного уровня Ландау по сравнению с переходами на соседние расщепленные подуровни.

Вычисление вероятности поглощения на магнитных подзонах проводилось по формуле (5). В магнитном поле, соответствующем числу квантов магнитного потока p/q = 15/1, для указанных параметров сверхрешетки $a = 9.71l_H$, что позволяет воспользоваться выражением (7) для расчета матричного элемента перехода.

Для того чтобы наглядно представить структуру спектра поглошения, мы рассчитали $\alpha(\nu)$ в случае, когда заполнены только состояния низшей подзоны Ландау (0, 1) вблизи $\mathbf{k} = 0$. Соответствующий спектр поглощения представлен на рис. 4. Показаны линии поглощения, связанные с переходами в состояния подзон (0, *n*) — область низких частот, и (1, *n*) — область высоких частот. Наиболее интенсивными оказываются переходы в состояния подзон (1, *n*); вероятность перехода в состояния (0, *n*) по порядку величины в $\beta^2 = 0.5$ раз меньше. Вероятность поглощения фотона вблизи точки $\mathbf{k} = 0$ существенно меняется в зависимости от номера магнитной подзоны конечного состояния: видны чередующиеся между собой линии разрешенных и запрещенных переходов. Это соответствует установленным выше правилам отбора. На вставках к рис. 4 показана тонкая структура линий поглощения разрешенных и запрещенных переходов вблизи центра магнитных подзон, отмеченных стрелками на основном рисунке. Разрешенным переходам ($P_{\mathbf{kk}}^{i \to f} \neq 0$) вблизи точки $\mathbf{k} = 0$ соответствуют характерные плато линий поглощения (см. вставку слева), в то время как для запрещенных переходов ($P_{\mathbf{kk}}^{i \to f} = 0$)



Рис. 4. Зависимость вероятности поглощения фотона сверхрешеткой квантовых точек с параметрами a = 80 нм; $V_0 = -20$ мэВ в магнитном поле, соответствующем p/q = 15/1, от частоты электромагнитного излучения. Частично заполнена низшая подзона Ландау (0, 1). Видны переходы в состояния подзон нулевого (N = 0) и первого (N = 1) уровней Ландау. На вставках: тонкая структура линий поглощения разрешенных $\alpha_{al}(\nu)$ и запрещенных $\alpha_{forb}(\nu)$ переходов, отмеченных стрелками

коэффициент поглощения растет линейно с частотой (вставка справа). Последнее связано с тем, что матричный элемент запрещенного перехода пропорционален $|\mathbf{k}|$. Ширина линий поглощения равна $\Delta^{i \to f} = |\Delta E_i - \Delta E_f|/\hbar$, где $\Delta E_{i,f} = |E_{i,f}(0) - E_{i,f}(k_F)|$ (k_F — квазиимпульс Ферми).

Для типичных концентраций 2D-электронов порядка 10¹¹ см⁻² заполняется несколько подзон нулевого уровня Ландау (при $H \approx 10^5$ Э), и это усложняет спектр поглощения. Рисунок 5 иллюстрирует зависимость вероятности поглощения фотона на переходах между подзонами Ландау в случае, когда полностью заполнены восемь нижних магнитных подзон (0, 1)... (0, 8), а девятая подзона (0, 9) — заполнена частично. Это соответствует концентрации носителей порядка 1.5 · 10¹¹ см⁻². На рис. 5 в области более низких частот видны линии поглощения, связанные с переходами между магнитными подзонами, отщепившимися от уровня Ландау N = 0. Первая низкочастотная линия поглощения, показанная на рисунке, обусловлена переходами между подзоной (0,9) и подзоной (0,10). Частоты этого и ближайших переходов находятся в миллиметровом СВЧ-диапазоне. Подобные переходы между магнитными подзонами одного уровня Ландау могут быть обнаружены с использованием методики наблюдения обычного циклотронного резонанса. Обычно понятие циклотронного резонанса связывается с электронными переходами между уровнями Ландау. Как было показано выше, наличие периодического потенциала приводит к расшеплению уровней Ландау на магнитные подзоны. Существенным оказывается тот факт, что в ψ -функциях электрона в подзонах существует примесь всех невозмущенных состояний Ландау (см. (3)). Вклад различных уровней Ландау в состояния подзон N₀-го невозмущенного уровня в линейном приближении по числу учтенных в разложении (3) уровней Ландау пропорционален параметру



Рис. 5. Зависимость вероятности поглощения фотона сверхрешеткой квантовых точек с параметрами a = 80 нм; $V_0 = -20$ мэВ в магнитном поле, соответствующем p/q = 15/1, от частоты электромагнитного излучения. Полностью заполнены восемь нижних подзон Ландау $(0, 1) \dots (0, 8)$, а девятая подзона (0, 9) заполнена частично. Стрелками обозначены переходы из указанных девяти заполненных подзон в подзону (1, 1). Знаком «+» обозначены переходы между подзонами $(0, 1) \rightarrow (1, n)$ (n = 1, p)

 β . Поэтому в общем случае возникает отличная от нуля вероятность перехода между подзонами, примыкающими к одному и тому же уровню Ландау. Это следует из анализа выражения (7) для матричного элемента перехода. Например, если заполнен ряд подзон нулевого уровня, то переходы в остальные подзоны данного уровня Ландау в основном описывает второе слагаемое, стоящее в скобках в выражении (7). Оно дает наибольший вклад (порядка β) в матричный элемент перехода. Таким образом, можно говорить о резонансах (циклотронных резонансах), связанных с переходами между подзонами, а не между уровнями Ландау. Экспериментальное изучение подобных спектров поглощения на магнитных подзонах может стать удобным инструментом исследования квантовых состояний блоховского электрона в магнитном поле.

На рис. 5 показаны также переходы из заполненных подзон нулевого уровня Ландау в магнитные подзоны, примыкающие к первому уровню Ландау. Здесь мы не приводим форму линий поглощения в увеличенном масштабе. Отметим лишь, что линия, описывающая переходы из полностью заполненной подзоны в пустую, имеет логарифмическую особенность в центре (форму пагоды), что связано с особенностями Ван Хова в плотности состояний. Наибольшая интенсивность поглощения соответствует переходу между подзонами $(0, 1) \rightarrow (1, 1)$.

В оригинальной работе [8], посвященной исследованию люминесценции в решетке антиточек (a = 200 нм) в магнитном поле ($H \le 2 \cdot 10^4$ Э) наблюдался эффект осцилляции интенсивности люминесценции, связанный с существованием соизмеримых орбит с циклотронными радиусами $2R_c = (S - 1/4)a$ (S — целое число). Нетрудно убедиться,

ЖЭТФ, 1998, 114, вып. 5(11)

что условие соизмеримости может быть выполнено в том случае, когда число заполненных уровней Ландау много больше единицы. Кроме того, наши специальные расчеты показали, что в условиях эксперимента [8] магнитные подзоны отдельных уровней Ландау сильно перекрыты. Заметим, что при параметрах, использованных в нашей работе, эффект соизмеримости орбит с периодом потенциала не может наблюдаться, так как частично заполнен лишь один уровень Ландау и ситуация далека от квазиклассической. Кроме того, магнитные подзоны различных уровней Ландау не перекрываются.

Таким образом, установлено, что исследование циклотронного резонанса и оптического поглощения в инфракрасной области может дать весьма ценную информацию о структуре блоховских состояний в 2*D*-решетке, находящейся в магнитном поле.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 98-02-16412).

Литература

- 1. М. Я. Азбель, ЖЭТФ 46, 929 (1964).
- 2. J. Zak, Phys. Rev. A 134, 1602 (1964); Phys. Rev. A 134, 1607 (1964).
- 3. A. Rauh, Phys. Stat. Sol (b) 65, K131 (1974).
- 4. D. R. Hofstadter, Phys. Rev. B 14, 2239 (1976).
- 5. H. Silberbauer, J. Phys. Condens. Matter 4, 7355 (1992).
- 6. D. Weiss, M. L. Roukes, A. Menschig et al., Phys. Rev. Lett. 66, 27 (1991).
- 7. D. Weiss, K. Richter, A. Menschig et al., Phys. Rev. Lett. 70, 4118 (1993).
- 8. I. V. Kukushkin, D. Weiss, G. Lütjering et. al., Phys. Rev. Lett. 79, 1722 (1997).
- 9. D. Weiss, D. Grambow, K. von Klitzing et al., Appl. Phys. Lett. 58, 2960 (1991).
- 10. T. Schlösser, K. Ensslin, J. P. Kotthaus et al., Semicond. Sci. Technol. 11, 1582 (1996).
- 11. В. Я. Демиховский, А. А. Перов, ФТТ 40, вып. 6 (1998).
- 12. A. A. Perov, Preprint, No SMR.998d-15, International Centre for Theoretical Physics, Trieste, (1997).
- 13. В. Я. Демиховский, А. А. Перов, в сб. Мегагауссная и мегаамперная импульсная технология и применения, Саров (1997).